

АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ СТРУКТУРИ ТА ФОНОННИХ СПЕКТРІВ В КРИСТАЛІЧНИХ УТВОРЕННЯХ 3 ($2a \times 2a \times 2a$) -НАДГРАТКОЮ ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУБІЧНА ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНА ФАЗА

I.М. Шкирта¹, І.І. Небола²

¹Мукачівський державний університет 89600, Мукачево, вул. Ужгородська, 26

²Ужгородський національний університет 88000, Ужгород, вул. А.Волошина, 54

Проведений детальний симетрійний аналіз модельних перетворень структур первоскитних кристалічних утворень типу ABC_3 із врахуванням дефектностей типів I ($ABCC \otimes$) та II ($AB \otimes \otimes C$) (де \otimes - вакансія) при можливій трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза; розраховані дисперсійні залежності фононних спектрів кристалу $BaTiO_3$ та похідних від нього кристалічних утворень з ($2a \times 2a \times 2c'$) - надграткою із врахуванням дефектностей типів I і II, а також досліджені їх особливості.

В лабораторіях світу щодня синтезується чимало нових матеріалів з особливими властивостями, які зумовлюють їх широке застосування в різноманітних областях сучасної техніки. До них відносяться високотемпературні надпровідники, сегнетоелектрики, сегнето-еластики, матеріали з характерним фазовим переходом типу метал-діелектрик, матеріали з комбінованими властивостями та інші, які раніше не можна було ні уявити, ні передбачити [1]. Саме виявлення багатьох нових структурних типів вищезгаданих матеріалів і стало поштовхом до активного пошуку їм подібних. Обширну групу складають кристали типу ABC_3 (де A, B – катіони, а C - аніон), основними елементами яких є октаедри BC_6 , а також похідні від ABC_3 сполуки, які надзвичайно багаті шаруватими первоскитоподібними кристалами (ШПК), побудованими двомірними шарами, зв'язаними вершинами октаедрів BC_6 , пірамід BC_5 , квадратів BC_4 , гантелей BC_2 [2]. Ці утворення можуть бути представлені у вигляді систем проростання декількох типів пакетів, (наприклад,

пакетів типів А, В, С або Д [2]), які можуть містити n шарів ($n = 1, 2, \dots$) октаедрів або їх залишків, з проміжними різnotипними блоками, що дає змогу шляхом кристалохімічного аналізу можливих комбінацій пакетів та блоків прогнозувати нові типи ШПК.

Дослідження сегнетоелектриків зі структурою типу $BaTiO_3$ дало змогу з'ясувати ряд важливих питань стосовно природи фазових переходів, нелінійних ефектів, розвинуті уявлення про нерозмірну структурну впорядкованість. Подібні кристалічні утворення володіють корисними електричними, магнітними, каталітичними властивостями і в останній час викликають значний інтерес у спеціалістів з фізики твердого тіла та споріднених з нею розділів фізичної науки. Так, зокрема, сегнетоелектрики-напівпровідники [3], на основі складних оксидів титану, знаходять широкі застосування при виготовленні активних елементів датчиків температури (від кріогенних до 400°C), елементів для високоефективного теплового та струмового захисту електрообладнання та електронних пристрій, автотермостабілізуючих нагрі-

важів різного призначення, активних елементів генераторів інфрациркульних частот, конденсаторних матеріалів з надвисокою діелектричною проникністю [4].

Серед широкої різноманітності структурних типів, відомих на даний час, без попереднього проведення детального симетрійного аналізу коливних представлень розібраться не так легко. Це ускладнює виявлення і встановлення в них певних закономірностей. Такий аналіз проведемо, виходячи з концепції надпросторової симетрії, згідно якої коливні представлення отримаємо під кожну позицію атома структури.

Розпочнемо аналіз з опису базової структури типу ABC_3 , зокрема, кристалу $BaTiO_3$, а вже потім перейдемо до структур, похідних від $BaTiO_3$ із врахуванням дефектностей типів I та II.

Узагальнена симетрія в складних кристалах проявляється через додаткову трансляційну інваріантність, що реалізується між позиціями природних надграток. Подальше узагальнення точкової симетрії реалізується через побудову модуляційних функцій масового, векторного та тензорного типу [5].

Структура багатокомпонентного кристалу $BaTiO_3$ - представника оксидних систем складу ABO_3 , моделюється як природна надгратка $(2a \times 2a \times 2a)$ (рис. 1) [5].

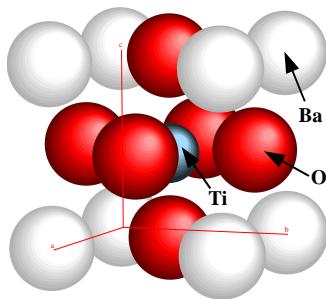


Рис. 1. Кристалічна структура $BaTiO_3$.

Кристал $BaTiO_3$ є одним з основних компонентів сегнетоелектричних матеріалів, оскільки його електричні властивості можна змінювати шляхом введення в кристалічну гратку легуючих домішок.

Опис кубічного кристалу $BaTiO_3$ з $(2a \times 2a \times 2a)$ - надграткою закладено в $(3+3)$ – вимірному базисі, а саме:

- прямому

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= (a, 0, 0, -b / 2, 0, 0) \\ \mathbf{a}_2 &= (0, a, 0, 0, -b / 2, 0) \\ \mathbf{a}_3 &= (0, 0, a, 0, 0, -b / 2) \\ \mathbf{a}_4 &= (0, 0, 0, b, 0, 0) \\ \mathbf{a}_5 &= (0, 0, 0, 0, b, 0) \\ \mathbf{a}_6 &= (0, 0, 0, 0, 0, b) \end{aligned} \quad (1)$$

та - оберненому

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1^* &= (2\pi / a, 0, 0, 0, 0, 0) \\ \mathbf{a}_2^* &= (0, 2\pi / a, 0, 0, 0, 0) \\ \mathbf{a}_3^* &= (0, 0, 2\pi / a, 0, 0, 0) \\ \mathbf{a}_{3+1}^* &= (\pi / a, 0, 0, 2\pi / b, 0, 0) \\ \mathbf{a}_{3+2}^* &= (0, \pi / a, 0, 0, 2\pi / b, 0) \\ \mathbf{a}_{3+3}^* &= (0, 0, \pi / a, 0, 0, 2\pi / b) \end{aligned}, \quad (2)$$

Трьохмірні компоненти векторів $\mathbf{a}_{3+1}^*, \mathbf{a}_{3+2}^*, \mathbf{a}_{3+3}^*$ оберненого базису визначають елементарні вектори модуляції, тобто,

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1 &= (\pi / a, 0, 0) \\ \mathbf{q}_2 &= (0, \pi / a, 0) \\ \mathbf{q}_3 &= (0, 0, \pi / a) \end{aligned}. \quad (3)$$

Оскільки структура ідеального $BaTiO_3$ є кубічною, то елементи точкової групи об'єднують позиції іонів в елементарній комірці складного кристалу в орбіти. В оберненому просторі сукупність векторів модуляції об'єднуються в зірки.

Повний набір векторів модуляції визначається сукупністю лінійних комбінацій елементарних векторів модуляції (3) в межах об'єму зони Бриллюєна (ЗБ) і містить 8 векторів модуляції виду:

$$\begin{aligned} q_1 &= q_{000} = (0, 0, 0) \\ q_2 &= q_{100} = (\pi / a, 0, 0) \\ q_3 &= q_{010} = (0, \pi / a, 0) \\ q_4 &= q_{001} = (0, 0, \pi / a) \\ q_5 &= q_{110} = q_{100} + q_{010} = (\pi / a, \pi / a, 0) \\ q_6 &= q_{101} = q_{100} + q_{001} = (\pi / a, 0, \pi / a) \\ q_7 &= q_{011} = q_{010} + q_{001} = (0, \pi / a, \pi / a) \\ q_8 &= q_{111} = q_{100} + q_{010} + q_{001} = (\pi / a, \pi / a, \pi / a) \end{aligned}, \quad (4)$$

що розпадаються на 4 зірки, з яких: дві одновекторні - $(0, 0, 0)$ та $(\pi / a, \pi / a, \pi / a)$ і

дві трьохвекторні – $(\pi/a, \pi/a, 0)$ та $(\pi/a, 0, 0)$.

При виборі базису (1) зірки відповідають восьми орбітам, які визначені радіус-векторами: $(0,0,0)$, $(a,0,0)$, $(0,a,0)$, $(0,0,a)$, (a,a,a) , $(a,a,0)$, $(a,0,a)$, $(0,a,a)$. Очевидно, що період мультиплікації композиційної надгратки дорівнює двом.

Рівність потужностей множин векторів модуляції і позицій атомів дозволяє записати для кристалів кубічної сингонії з $(2a \times 2a \times 2a)$ -надграткою систему рівнянь відносно амплітуд масових модуляційних функцій $\rho(q_j) = \rho_j$ ($j=1, 2, \dots, s; s=8$) [5-7] у вигляді:

$$M(r_k) = \sum_{j=1}^s \rho(q_j) \exp\{iq_j r_k\}, \quad (5)$$

де $M(r_k)$ – маса атомів у позиціях r_k ; q_j – вектори модуляції ($j, k = \overline{1, 8}$).

Система (5) у явному вигляді має вид:

$$\begin{aligned} M_1 &= \rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7 + \rho_8 \\ M_2 &= \rho_1 - \rho_2 + \rho_3 + \rho_4 - \rho_5 - \rho_6 - \rho_7 + \rho_8 \\ M_3 &= \rho_1 + \rho_2 - \rho_3 + \rho_4 - \rho_5 - \rho_6 + \rho_7 - \rho_8 \\ M_4 &= \rho_1 + \rho_2 + \rho_3 - \rho_4 - \rho_5 + \rho_6 - \rho_7 - \rho_8, \quad (6) \\ M_5 &= \rho_1 - \rho_2 - \rho_3 - \rho_4 - \rho_5 + \rho_6 + \rho_7 + \rho_8 \\ M_6 &= \rho_1 - \rho_2 - \rho_3 + \rho_4 + \rho_5 + \rho_6 - \rho_7 - \rho_8 \\ M_7 &= \rho_1 - \rho_2 + \rho_3 - \rho_4 + \rho_5 - \rho_6 + \rho_7 - \rho_8 \\ M_8 &= \rho_1 + \rho_2 - \rho_3 - \rho_4 + \rho_5 - \rho_6 - \rho_7 + \rho_8 \end{aligned}$$

де M_i – маси атомів у позиціях $(0,0,0)$, $(a,0,0)$, $(0,a,0)$, $(0,0,a)$, (a,a,a) , $(a,a,0)$, $(a,0,a)$, $(0,a,a)$, відповідно.

Її розв'язок:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5 + M_6 + M_7 + M_8}{8} \\ \rho_2 &= \frac{M_1 - M_2 - M_3 + M_4 + M_5 + M_6 - M_7 - M_8}{8} \\ \rho_3 &= \frac{M_1 - M_2 + M_3 - M_4 + M_5 - M_6 + M_7 - M_8}{8} \\ \rho_4 &= \frac{M_1 + M_2 - M_3 - M_4 + M_5 - M_6 - M_7 + M_8}{8} \\ \rho_5 &= \frac{M_1 - M_2 - M_3 - M_4 - M_5 + M_6 + M_7 + M_8}{8} \\ \rho_6 &= \frac{M_1 - M_2 + M_3 + M_4 - M_5 - M_6 - M_7 + M_8}{8} \\ \rho_7 &= \frac{M_1 + M_2 - M_3 + M_4 - M_5 - M_6 + M_7 - M_8}{8} \\ \rho_8 &= \frac{M_1 + M_2 + M_3 - M_4 - M_5 + M_6 - M_7 - M_8}{8} \end{aligned} \quad (7)$$

Функція масової модуляції $M(r_k)$ визначена на дискретній множині точок

кристалічного простору, що задаються радіус-вектором вузлів базової структури r_k .

(3+3)-вимірні базиси (1, 2) із врахуванням масових співвідношень:

$$\begin{aligned} M_1 &= m_{Ba}, M_5 = m_{Ti}, \\ M_6 &= M_7 = M_8 = m_o, \\ M_2 &= M_3 = M_4 = 0, \end{aligned} \quad (8)$$

дозволяють записати мотив кристалу $BaTiO_3$ через мотив протокристалу

$$\rho_1 = \frac{m_{Ba} + m_{Ti} + 3m_o}{8} \quad (9)$$

та модулюючі добавки

$$\begin{aligned} \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 &= \frac{m_{Ba} + m_{Ti} - m_o}{8}; \\ \rho_5 &= \frac{m_{Ba} - m_{Ti} + 3m_o}{8}; \\ \rho_6 = \rho_7 = \rho_8 &= \frac{m_{Ba} - m_{Ti} - m_o}{8}. \end{aligned} \quad (10)$$

Узагальнена динамічна матриця складного кристалу $BaTiO_3$ визначається композиційним складом його елементарної комірки, симетрією гратки та характером моделей силових постійних. Врахування узагальненої надпросторової симетрії накладає ряд фундаментальних обмежень на фононні спектри складних кристалів [9-12].

Комбінації елементарних модуляційних векторів (3) приводять до системи восьми трьохмірних рівнянь руху, що виражається в узагальненій динамічній матриці розмірності (24×24) . Закони дисперсії фононного спектру $\omega^2(\mathbf{k})$ є розв'язками задачі на власні значення:

$$|D^{cl}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})M| = 0, \quad (11)$$

де M – діагональна матриця, елементами якої є відповідні маси атомів, а динамічна матриця складного кристалу традиційно [8] записується у вигляді:

$$D_{\alpha\beta}^{cl}(k, k' | \mathbf{k}) = -\sum_l K_{\alpha\beta}(lk, l'k') \exp\{i\mathbf{k}[\mathbf{x}(l') - \mathbf{x}(l)]\}. \quad (12)$$

Повний набір векторів модуляції (4) разом з амплітудами модуляційних векторів (7) дозволяє записати рівняння руху в надпросторовому підході [5-7], в якому квадрати фононних частот також є розв'язками секулярного рівняння:

$$|D^{sp}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})M| = 0, \quad (13)$$

$$D_N^{sp}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} D_1^1(\mathbf{k}) & D_1^2(\mathbf{k}) & D_1^3(\mathbf{k}) & D_1^4(\mathbf{k}) & D_1^5(\mathbf{k}) & D_1^6(\mathbf{k}) & D_1^7(\mathbf{k}) & D_1^8(\mathbf{k}) \\ D_2^2(\mathbf{k}) & D_2^1(\mathbf{k}) & D_2^6(\mathbf{k}) & D_2^8(\mathbf{k}) & D_2^7(\mathbf{k}) & D_2^3(\mathbf{k}) & D_2^5(\mathbf{k}) & D_2^4(\mathbf{k}) \\ D_3^3(\mathbf{k}) & D_3^6(\mathbf{k}) & D_3^1(\mathbf{k}) & D_3^7(\mathbf{k}) & D_3^8(\mathbf{k}) & D_3^2(\mathbf{k}) & D_3^4(\mathbf{k}) & D_3^5(\mathbf{k}) \\ D_4^4(\mathbf{k}) & D_4^8(\mathbf{k}) & D_4^7(\mathbf{k}) & D_4^1(\mathbf{k}) & D_4^6(\mathbf{k}) & D_4^5(\mathbf{k}) & D_4^3(\mathbf{k}) & D_4^2(\mathbf{k}) \\ D_5^5(\mathbf{k}) & D_5^7(\mathbf{k}) & D_5^8(\mathbf{k}) & D_5^6(\mathbf{k}) & D_5^1(\mathbf{k}) & D_5^4(\mathbf{k}) & D_5^2(\mathbf{k}) & D_5^3(\mathbf{k}) \\ D_6^6(\mathbf{k}) & D_6^3(\mathbf{k}) & D_6^2(\mathbf{k}) & D_6^5(\mathbf{k}) & D_6^4(\mathbf{k}) & D_6^1(\mathbf{k}) & D_6^8(\mathbf{k}) & D_6^7(\mathbf{k}) \\ D_7^7(\mathbf{k}) & D_7^5(\mathbf{k}) & D_7^4(\mathbf{k}) & D_7^3(\mathbf{k}) & D_7^2(\mathbf{k}) & D_7^8(\mathbf{k}) & D_7^1(\mathbf{k}) & D_7^6(\mathbf{k}) \\ D_8^8(\mathbf{k}) & D_8^4(\mathbf{k}) & D_8^5(\mathbf{k}) & D_8^2(\mathbf{k}) & D_8^3(\mathbf{k}) & D_8^7(\mathbf{k}) & D_8^6(\mathbf{k}) & D_8^1(\mathbf{k}) \end{pmatrix}. \quad (14)$$

В запропонованому підході розраховано фононний спектр кристалу $BaTiO_3$ (рис. 2). При цьому мають місце як модуляція маси, так і модуляція силових постійних. Відмічається хороше узгодження розрахованих дисперсійних кривих з експериментом [13].

Теоретико-груповий аналіз фазових переходів в кристалах типу $BaTiO_3$ проводився в ряді робіт [9-12]. Однак, опис фаз в термінах теорії федорівських просторових груп, не можна вважати вичерпним. В зв'язку з цим проведено розділення коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході.

Суть методу класифікації коливних мод полягає в знаходженні повного коливного зображення, яке для кристалу $BaTiO_3$ має розмірність 15 з послідовочним його розкладом за незвідними зображеннями фактор-групи кристалу.

Для отримання розкладу повного коливного зображення за незвідними зображеннями в надпросторовому підході

де M - матриця оператора дефекту мас [5], а $D^{sp}(\mathbf{k})$ - узагальнена динамічна матриця, побудована на динамічних матрицях одноатомної базової структури, визначених у точках $(\mathbf{k} + \mathbf{q}_i)$ ЗБ. Власні значення матриці $D^{sp}(\mathbf{k})$ визначають енергетично вироджений стан протокристалу [5, 6].

Узагальнена динамічна матриця для кристалів типу $BaTiO_3$ має вигляд:

достатньо знати характеристи, які визначаються наступним чином:

$$\chi(g_s, g_d) = \chi(R_s) \sum_{\substack{j, j'=j' \\ R_d b^* = b^*}} \exp\{i(k - \Delta^* b^*) u(j)\}, \quad (15)$$

де (g_s, g_d) – просторові елементи, (R_s, R_d) – точкові елементи, $\Delta^* b^* = q$, b^* - обернений базовий вектор фазового простору, $u(j)$ служить для узгодження трансляційних та точкових операцій симетрії при їх дії на модуляційні функції.

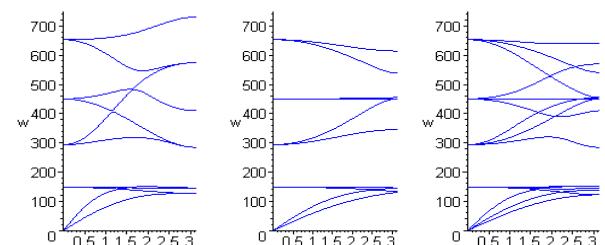


Рис. 2. Фононний спектр кристалу $BaTiO_3$
 $\alpha_1(Ti-O) = 28.5 \text{ H/m}$, $\alpha_2(Ba-O) = 50.15 \text{ H/m}$,
 $\alpha_2(O-O) = 75.8 \text{ H/m}$, $\alpha_3(Ba-Ti) = 8.19 \text{ H/m}$.

Проведений теоретико-груповий аналіз особливостей поведінки фононних

віток в околі точки Γ . Коливне зображення при цьому має вигляд:

$$\begin{aligned}\Gamma_{vibr}(O_h^1) &= \tau_{10}(Ba) + \tau_{10}(Ti) + \tau_8(O) + 2\tau_{10}(O) = \\ &= \tau_8 + 4\tau_{10}\end{aligned}\quad (16)$$

При переході з кубічної фази в тетрагональну в центрі та на границі зони Бриллюєна спостерігається зняття трохкратного виродження для незвідного зображення τ_{10} (таблиця 1) з розщепленням його на однократне τ_4 та двохкратне τ_{10} і незвідного зображення τ_8 з розщепленням його на однократні τ_4 та τ_8 .

При цьому (16) набуде вигляду:

$$\begin{aligned}\Gamma_{vibr}(D_{4h}^1) &= \tau_4(Ba) + \tau_{10}(Ba) + \tau_4(Ti) + \tau_{10}(Ti) + \\ &+ \tau_8(O) + 2\tau_{10}(O) = 4\tau_4 + \tau_8 + 5\tau_{10}\end{aligned}\quad (17)$$

Таблиця 1

Атоми (позиції)	Розклади за незвідними зображеннями	
	O_h^1	D_{4h}^1
$Ba(0,0,0)$	τ_{10}	$\tau_4 + \tau_{10}$
$Ti(a,a,a)$	τ_{10}	$\tau_4 + \tau_{10}$
$O_1(a,a,0)$	$1/3\tau_8 + 2/3\tau_{10}$	$\tau_4 + \tau_{10}$
$O_2(a,0,a)$	$1/3\tau_8 + 2/3\tau_{10}$	$1/2\tau_4 + 1/2\tau_8 + \tau_{10}$
$O_3(0,a,a)$	$1/3\tau_8 + 2/3\tau_{10}$	$1/2\tau_4 + 1/2\tau_8 + \tau_{10}$

Це характерно для похідних дефектних типів I [тип A ($BaTiOO\otimes$)] та II [тип B ($BaTi\otimes\otimes O$)], де \otimes - вакансія у відповідних позиціях атомів кисню. При подібних перетвореннях структур з кубічної в одну з тетрагональних фаз, спостерігається складна перебудова вироджень фононного спектру.

Виходячи з принципів концепції надпросторової симетрії, одержані розклади для всіх можливих векторів \vec{k}_i для випадків кубічної симетрії (табл. 2-3), а також повні коливні зображення (табл. 4):

Таблиця 2

Атоми (позиції)	Розклади за незвідними зображеннями	
	для лінії Λ	для лінії Δ
$Ba(0,0,0)$	$\tau_1 + \tau_3$	$\tau_1 + \tau_5$
$Ti(a,a,a)$	$\tau_1 + \tau_3$	$\tau_1 + \tau_5$
$O_1(a,a,0)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$\tau_1 + \tau_5$
$O_2(a,0,a)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$\frac{1}{2}\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_3 + \tau_5$
$O_3(0,a,a)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$\frac{1}{2}\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_3 + \tau_5$

Таблиця 3

Атоми (позиції)	Розклади за незвідними зображеннями	
	для лінії Σ	для випадку точки X або M
$Ba(0,0,0)$	$\tau_1 + \tau_3 + \tau_4$	$\tau_4 + \tau_{10}$
$Ti(a,a,a)$	$\tau_1 + \tau_3 + \tau_4$	$\tau_4 + \tau_{10}$
$O_1(a,a,0)$	$\tau_1 + \tau_3 + \tau_4$	$\tau_4 + \tau_{10}$
$O_2(a,0,a)$	$\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_2 + \tau_3 + \frac{1}{2}\tau_4$	$\tau_4 + \tau_6 + \tau_8$
$O_3(0,a,a)$	$\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_2 + \tau_3 + \frac{1}{2}\tau_4$	$\tau_4 + \tau_6 + \tau_8$

Таблиця 4

Вектор k_i	Повне коливне зображення
$k_{12}, k_{13}(\Gamma, R)$	$\tau_8 + 4\tau_{10}$
$k_{10} k_{11}(M, X)$	$4\tau_4 + \tau_8 + 5\tau_{10}$
$k_9(\Lambda)$	$4\tau_1 + \tau_2 + 5\tau_3$
$k_8(\Delta)$	$4\tau_1 + \tau_3 + 5\tau_5$
$k_4(\Sigma)$	$5\tau_1 + \tau_2 + 5\tau_3 + 4\tau_4$

В зв'язку з цим проведено розділення коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході.

Для дослідження генезису фононних спектрів складних кубічних кристалів з надграткою $(2a \times 2a \times 2a)$ проводились чисельні розрахунки фононних спектрів в нееквідистантному наближенні для високосиметричних напрямків ЗБ.

Розрахунки фононних спектрів кристалу $BaTiO_3$ проведено для випадків кубічної та тетрагональних (І і ІІ) фаз. Високочастотні коливання характерні для атому кисню, а низькочастотні – для атомів барію та титану. В точці Г для випадку кубічної прафази наявні трохкратні виродження фононних частот, а саме: $653.59(3) \text{ cm}^{-1}$, $450.47(3) \text{ cm}^{-1}$, $293.49(3) \text{ cm}^{-1}$, $147.82(3) \text{ cm}^{-1}$. По мірі появи дефектності спостерігаються розщеплення фононних частот, зокрема:

- для випадку тетрагональної фази І: $577.48(2) \text{ cm}^{-1}$, 450.47 cm^{-1} , 343.36 cm^{-1} , $320.28(2) \text{ cm}^{-1}$, $147.97(2) \text{ cm}^{-1}$, 147.97 cm^{-1} ;

- для випадку тетрагональної фази ІІ: 394.74 cm^{-1} , $382.07(2) \text{ cm}^{-1}$, 148.12 cm^{-1} , $148.10(2) \text{ cm}^{-1}$, де в дужках показані степені виродження фононних частот.

В результаті розроблена процедура модельних розрахунків дисперсії фононних спектрів кристалічних структур сімейства кристалів з $(2a \times 2a \times 2a)$ природною надграткою, в якій досліджено їх трансформацію, в залежності від композиційних і силових варіацій в системах ABC_3 з $(2a \times 2a \times 2c)$ -надграткою (рис. 2).

Таким чином, дана методика дозволяє проводити детальний симетрійний аналіз по вивченю особливостей структур нових високотемпературних надпровідників, сегнетоелектриків, сегнетоеластиків та інших нових матеріалів, похідних від структури $BaTiO_3$, а також вивчати особливості їх фононних спектрів при структурних перетвореннях.

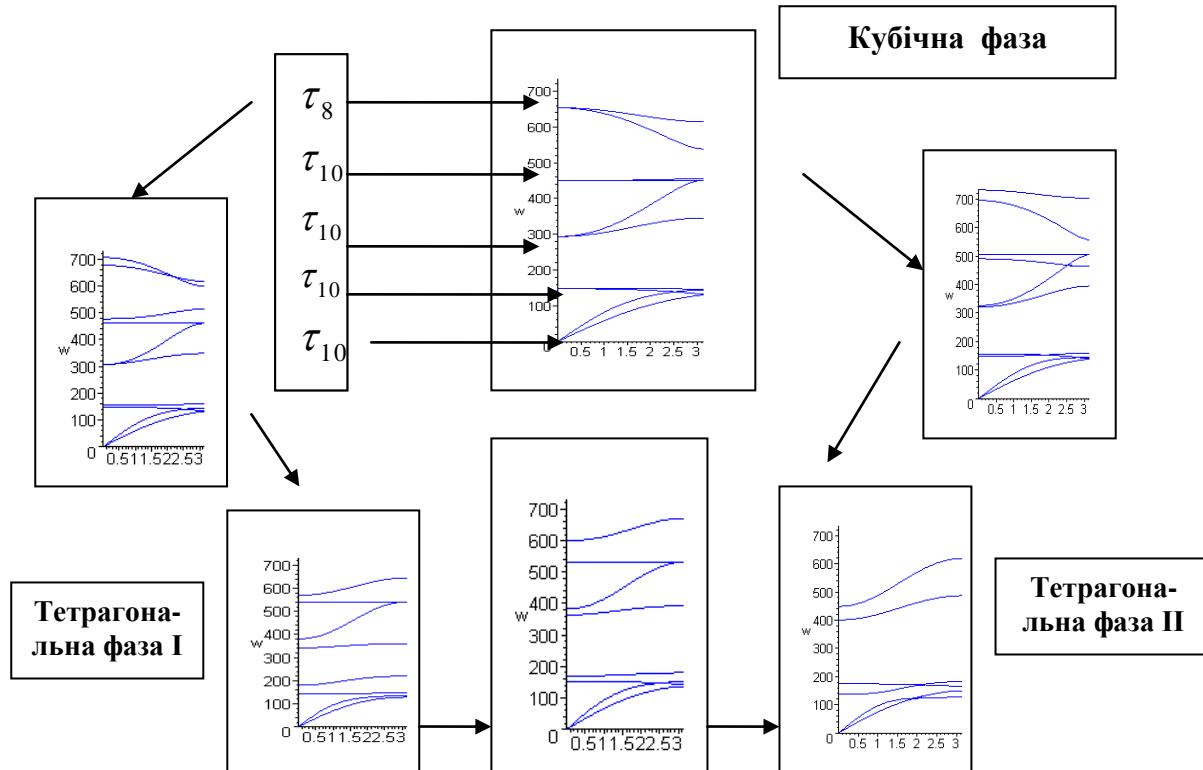


Рис. 3. Модифікація фононного спектру кристалу $BaTiO_3$ для напрямку Γ -Z при фазових перетвореннях типів: кубічна фаза – тетрагональна фаза І, кубічна фаза – тетрагональна фаза ІІ, тетрагональна фаза І - тетрагональна фаза ІІ.

Література

1. Александров К.С., Безносиков Б.В. Иерархия первоскитоподобных кристаллов (Обзор) // ФТТ. – 1997. – Т.39, №5. – С. 785-808.
2. <http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/067.pdf>.
3. Zhang X.L. Research and Development of Electronic Ceramics in China / Proc. Conf. Electroceramics V.1996. – Sept. 2-4, Aveiro, Portugal, Book 1. - Р. 91-96.
4. Полупроводники на основе титаната бария / Пер. с японского И.Б. Рейга. – М.: Энергоиздат, 1982. – 325 с.
5. Небола И.И., Иваняс А.Ф., Киндрат В.Я. Генезис структуры и колебательных спектров кристаллов с $(sa \times sa \times sa)$ -сверхрешеткой // ФТТ. – 1993. – Т.35, №7. – С. 1852-1866.
6. Небола И.И., Хархалис Н.Р., Копчик А.В. Дисперсия фононного спектра сложных кристаллов типа NaCl в концепции сверхпространственной симметрии // ФТТ. – 1987. – Т. 29, № 11. – С. 3223-3232.
7. Небола I.I. Композиційні особливості складних кристалів та їх прояв у динаміці гратки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – №2, – 1998. – С. 54-57.
8. Janner A., Janssen T. Symmetry of incommensurate crystal phases. 2. Incommensurate basic structures // Acta. Cryst. – 1980. – Vol. A36. – P. 408-415.
9. Janssen T., Janner A. Superspace groups and representations of ordinary space groups: alternative approaches to the symmetry of incommensurate crystal phases // Physica.-1984. - Vol. 126A. – P. 163-176.
10. P.M. de Wolff, Janssen T., Janner A. The superspace groups of incommensurate crystal structures with a one-dimensional modulation // Acta. Cryst. – 1981. – Vol. A37. – P. 625-636.
11. Janssen T. On the lattice dynamics of incommensurate crystal phases // J. Phys. C: Solid State Phys. – 1979. – Vol.12. – P. 1534 – 1543.
12. Janner A., Janssen T. Symmetry of incommensurate crystal phases. 1. Commensurate basic structures // Acta. Cryst. – 1980. – Vol. A36. – P. 399-408.
13. Khatib D., Migoni R., Kugel G.E. and Godefroy L. Lattice dynamics of $BaTiO_3$ in the cubic phase // J.Phys.: Condens. Matter. – 1989. – Vol.1. – P. 9811-9822.

ANALYSIS OF TRANSFORMATIONS OF STRUCTURE AND PHONON SPECTRUMS IN CRYSTALLINE EDUCATIONS FROM $(2a \times 2a \times 2a)$ -SYPERLATTICE DURING TRANSFORMATION CUBIC PHASE – TETRAGONAL PHASE

I.N. Shkirta¹, I.I. Nebola²

¹Mukachevo State University, 26 Uzhhorodska Str., 89600, Mukachevo, Ukraine
²Uzhhorod National University, 54 Voloshin Str., 88000, Uzhhorod, Ukraine

The detailed symmetry analysis of models transformations of structures of perovskite of crystalline formations of type ABC_3 is conducted ABC_3 recognition defects types I ($ABCC \otimes$) but II ($AB \otimes \otimes C$) (where \otimes is vacancy) during possible transformation a cube phase is a tetragonal phase; dispersion dependences of phonon spectrums are expected to the crystal $BaTiO_3$ and derivates from him crystalline educations from $(2a \times 2a \times 2c')$ -superlattice recognition defects types I and II, and also their features are investigational.

АНАЛИЗ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРЫ И ФОНОННЫХ СПЕКТРОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ С $(2a \times 2a \times 2a)$ -СВЕРХРЕШЕТКОЙ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ КУБИЧЕСКАЯ ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНАЯ ФАЗА

И.М. Шкирта¹, И.И. Небола²

¹Мукачевский государственный университет, 89600, Мукачево, ул. Ужгородская, 26

²Ужгородский национальный университет, 88000, Ужгород, ул. А.Волошина, 54

Проведен детальный симметричный анализ модельных преобразований структур первовскитных кристаллических образований типа ABC_3 с учетом дефектностей типов I ($ABCC \otimes$) и II ($AB \otimes \otimes C$) (где \otimes - вакансия) при возможной трансформации кубическая фаза – тетрагональная фаза; рассчитаны дисперсионные зависимости фононных спектров кристалла $BaTiO_3$ и производных от него кристаллических образований с $(2a \times 2a \times 2c')$ - сверхрешеткой с учетом дефектностей типов I и II, а также исследованы их особенности.